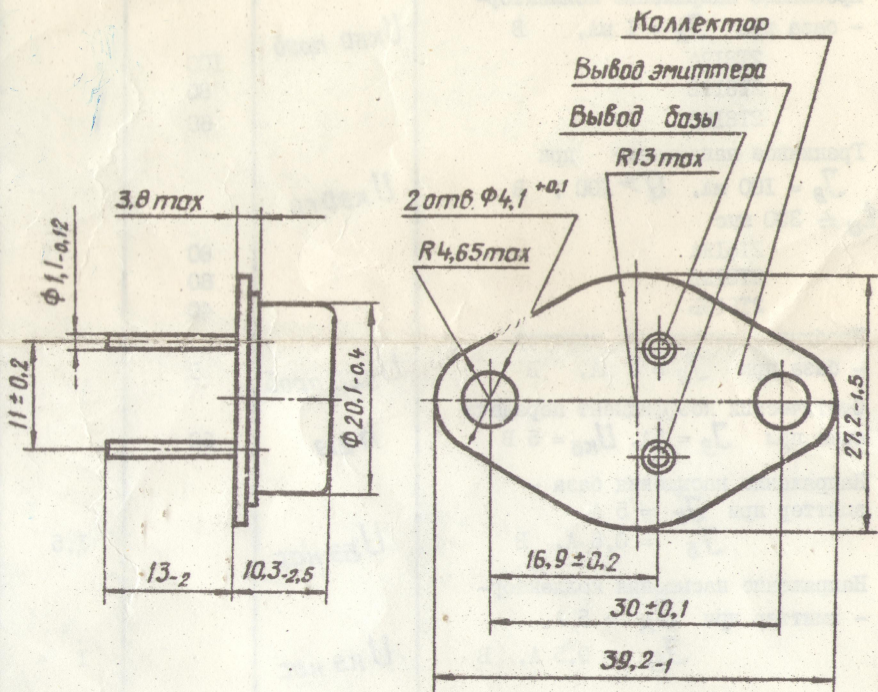


ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов 2Т819  
соответствуют требованиям  
технических условий  
АО.339.142 ТУ



Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.  
транзисторов

Золото 9932.5 (мг)

Масса транзистора не более 20г

Т.К.

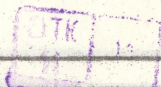
Валет-190894

Основные электрические параметры  
при  $t_{корр.} = +25 \pm 10^\circ \text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Пробивное напряжение коллектор-база при $J_K = 1 \text{ мА}$ , В 2Т819А 2Т819Б 2Т819В	$U_{кб0 \text{ проб}}$	100 80 60	
Граничное напряжение при $J_3 = 100 \text{ мА}$ , $Q > 100$ , В $t_{и} \leq 300 \text{ мкс}$ 2Т819А 2Т819Б 2Т819В	$U_{к30 гр}$	80 60 40	
Пробивное напряжение эмиттер-база при $J_3 = 5 \text{ мА}$ , В	$U_{350 \text{ проб}}$	5	
Статический коэффициент передачи тока при $J_3 = 5 \text{ А}$ , $U_{кв} = 5 \text{ В}$	$h_{213}$	20	
Напряжение насыщения база-эмиттер при $J_K = 5 \text{ А}$ $J_B = 0,5 \text{ А}$ , В	$U_{БЭ \text{ нас}}$		1,5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $J_K = 5 \text{ А}$ $J_B = 0,5 \text{ А}$ , В	$U_{кЭ \text{ нас}}$		1

Штамп ОТК

Штамп представителя  
заказчика



КТ